Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U006884

Державний реєстраційний номер: 0108U004836

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-03-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 3

Назва етапу: Виготовлення експериментальних зразків сенсорних діодних структур In/CdTe/Au методом лазерно-індукованого легування і тестування діодів на предмет їх чутливості до радіоізотопів. Визначення умов для отримання діодів придатних для розроблення детекторів рентгенівського і гама випромінювання та вимірювання їх функціональних параметрів.

Початок етапу: 01.2010

Закінчення етапу: 12.2010

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Президія Національної академії наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380 44 525-40-20 , 380 44 525-83-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 98.2

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення і створення матриць сенсорних діодних структур та приладу для детектування ядерного випромінювання

Назва роботи англійською:

Development and creation of sensor diode structure arrays and device for nuclear radiation detection

Реферат українською:

Виготовлено експериментальні зразки сенсорних діодних структур In/CdTe/Au методом лазерно-індукованого легування і тестування діодів на предмет їх чутливості до радіоізотопів. Визначено умови для отримання діодів придатних для розроблення детекторів рентгенівського і гама випромінювання та вимірювання їх функціональних параметрів.

Реферат англійською:

Experimental samples sensor diode structures In / CdTe / Au by laser-induced doping and testing diodes in terms of their sensitivity to radioisotopes. The conditions for receiving diodes suitable for the development of X-ray detectors and gamma rays and measure their functional parameters.

Індекс УДК: 621.384.6; 621.384.647, 621.386.82; 535.21

Коди тематичних рубрик: 47.29.39

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Власенко Олександр Іванович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Визначено умови для отримання діодів придатних для розроблення детекторів рентгенівського і гама випромінювання та вимірювання їх функціональних параметрів.

Назва НТП англійською: The conditions for receiving diodes suitable for the development of X-ray detectors and gamma rays and measure their functional parameters.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: К 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Визначено умови для отримання діодів придатних для розроблення детекторів рентгенівського і гама випромінювання та вимірювання їх функціональних параметрів.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: -

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НАНУ

Перспективні ринки: УКраїна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. V.A. Gnatyuk, T. Aoki, O.I. Vlasenko, S.N. Levytskyi, B.K. Dauletmuratov, C.P. Lambropoulos, Modification of the surface state and doping of CdTe and CdZnTe crystals by pulsed laser irradiation, Applied Surface Science, Vol. 255, No 24 (2009) 9813-9816. 2. V.A. Gnatyuk, T. Aoki, S.N. Levytskyi, O.I. Vlasenko, Photosensitive CdTe-based structures formed by laser irradiation // Proceeding of International Workshop on Field Emitter and Semiconductor Materials and Devices (IWFESMD-2010). - 2010. 20-25.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Велещук В.П.

Власенко З.К.

Гнатюк В. А.

Левицький С.М.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

